

TRANSISTORS PNP

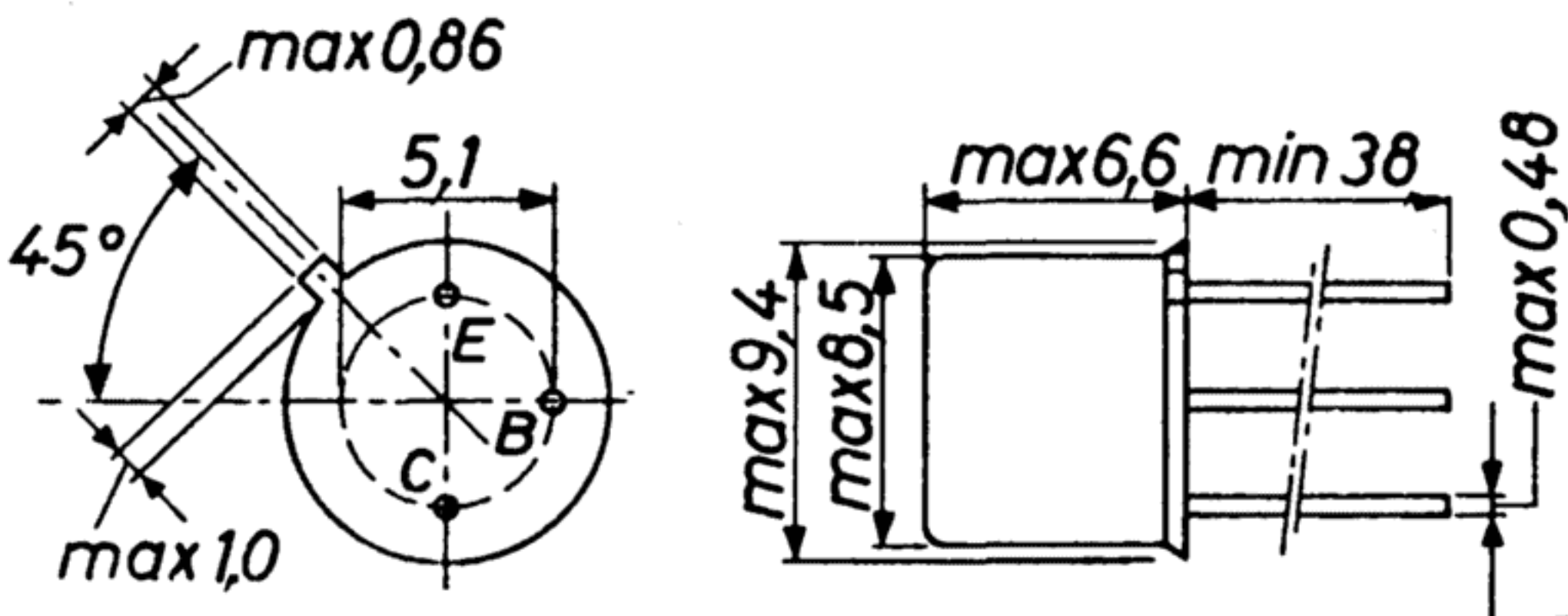
par alliage au germanium

ASY76
ASY77
ASY80

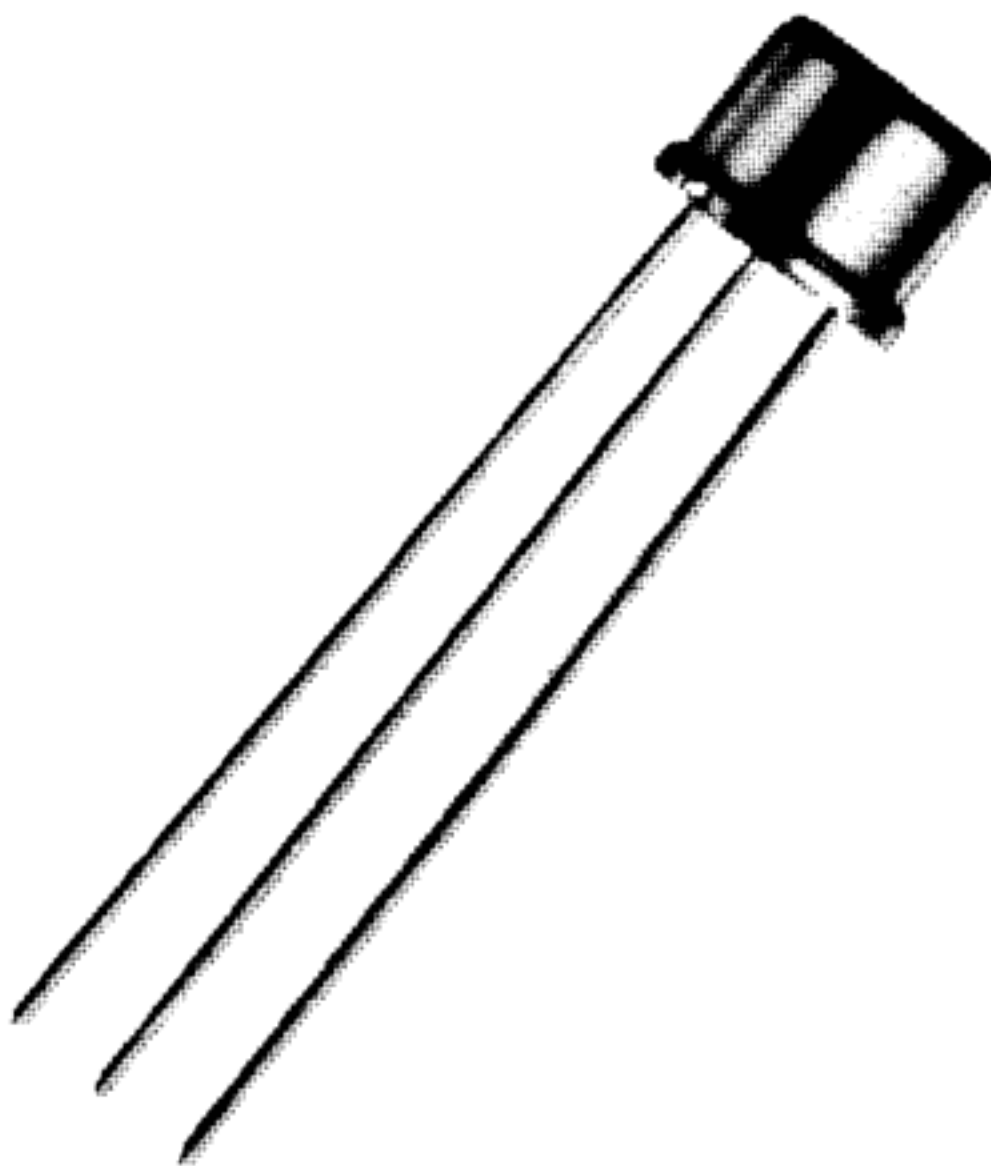
Cette série de transistors trouve son emploi dans la commutation lente à niveau moyen. Elle est remarquable par sa grande robustesse aux surcharges de courant.

www.datasheetcatalog.com

Disposition des électrodes
et encombrement



Boîtier JEDEC TO-5
base reliée au boîtier
Poids : 0,9 g environ



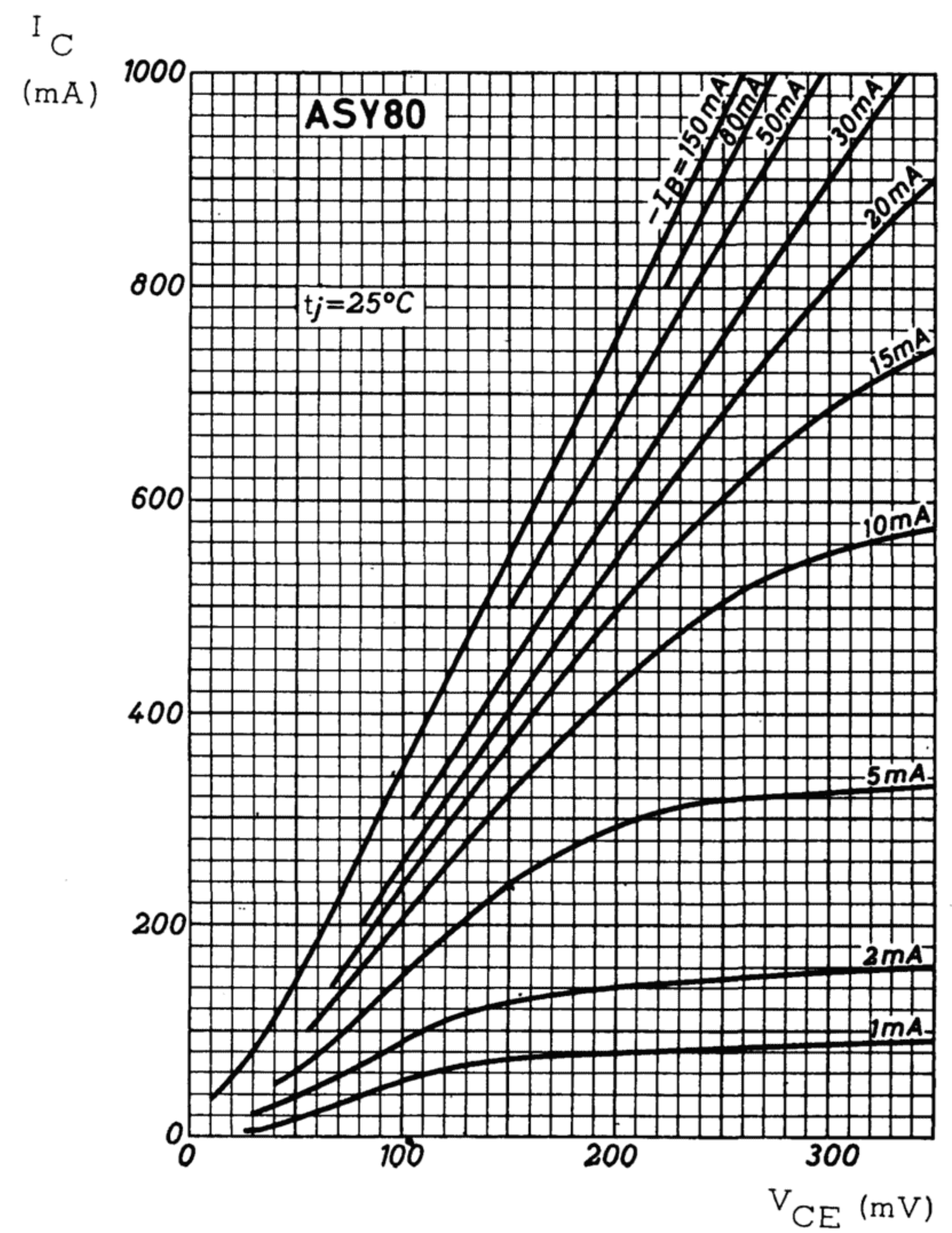
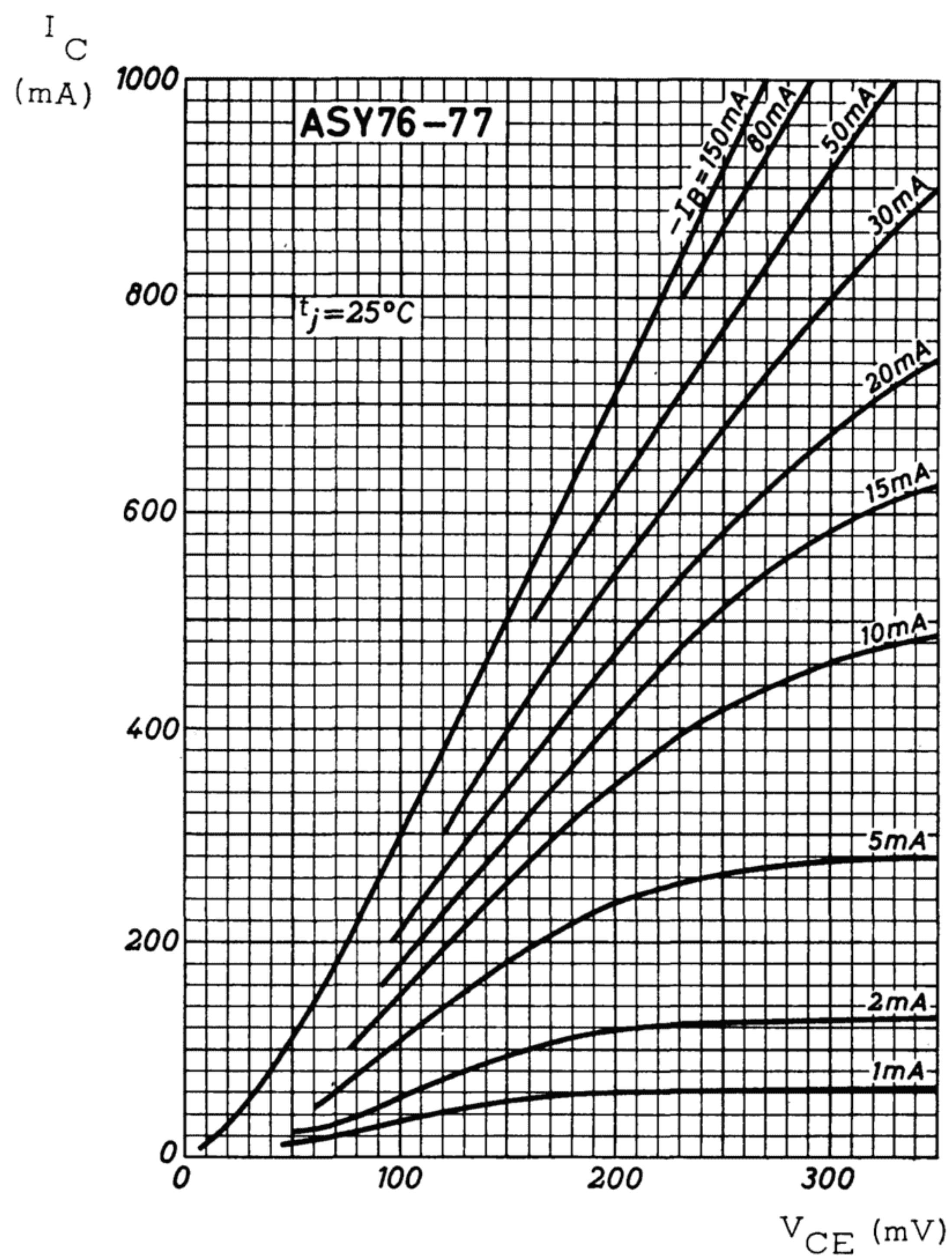
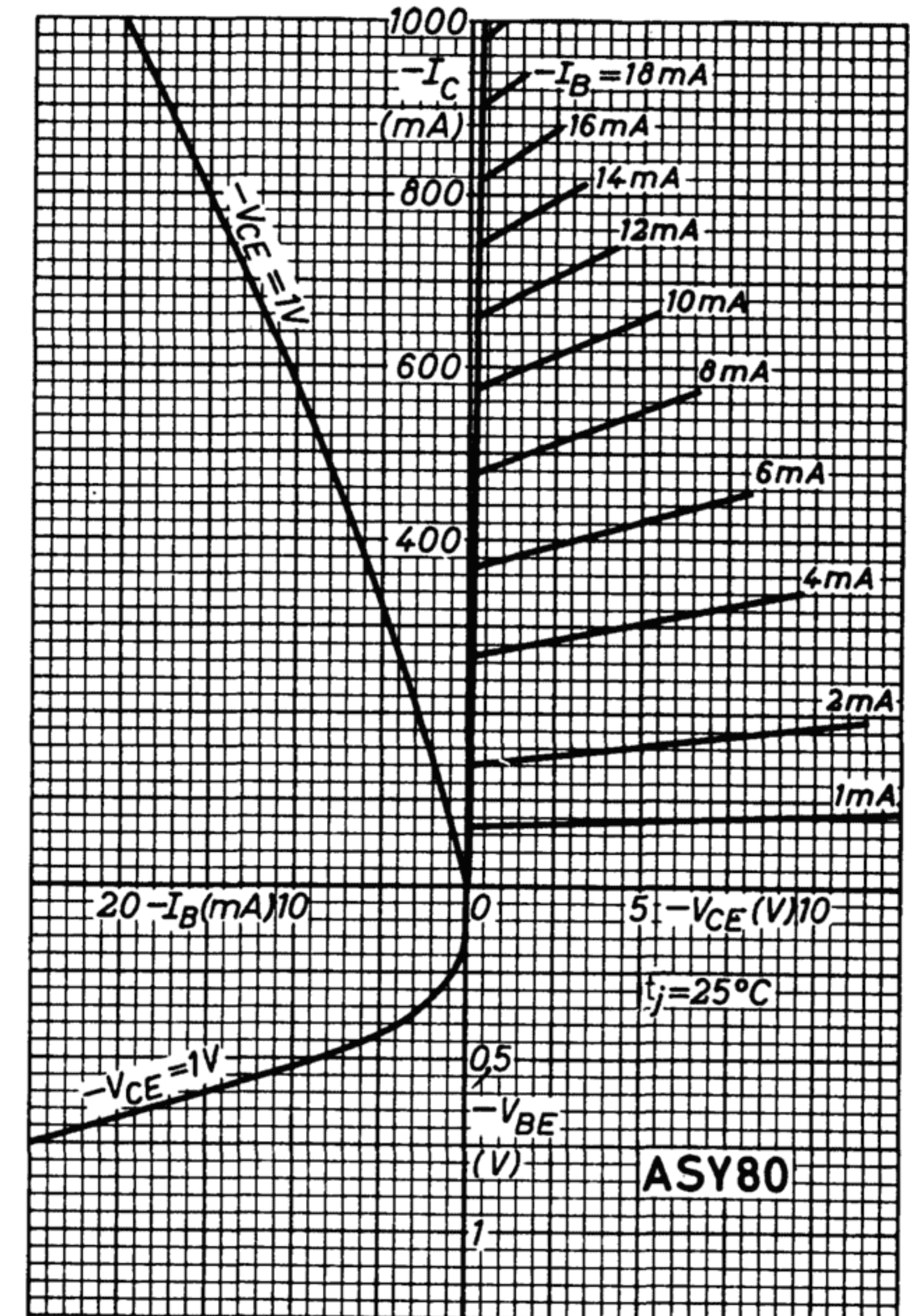
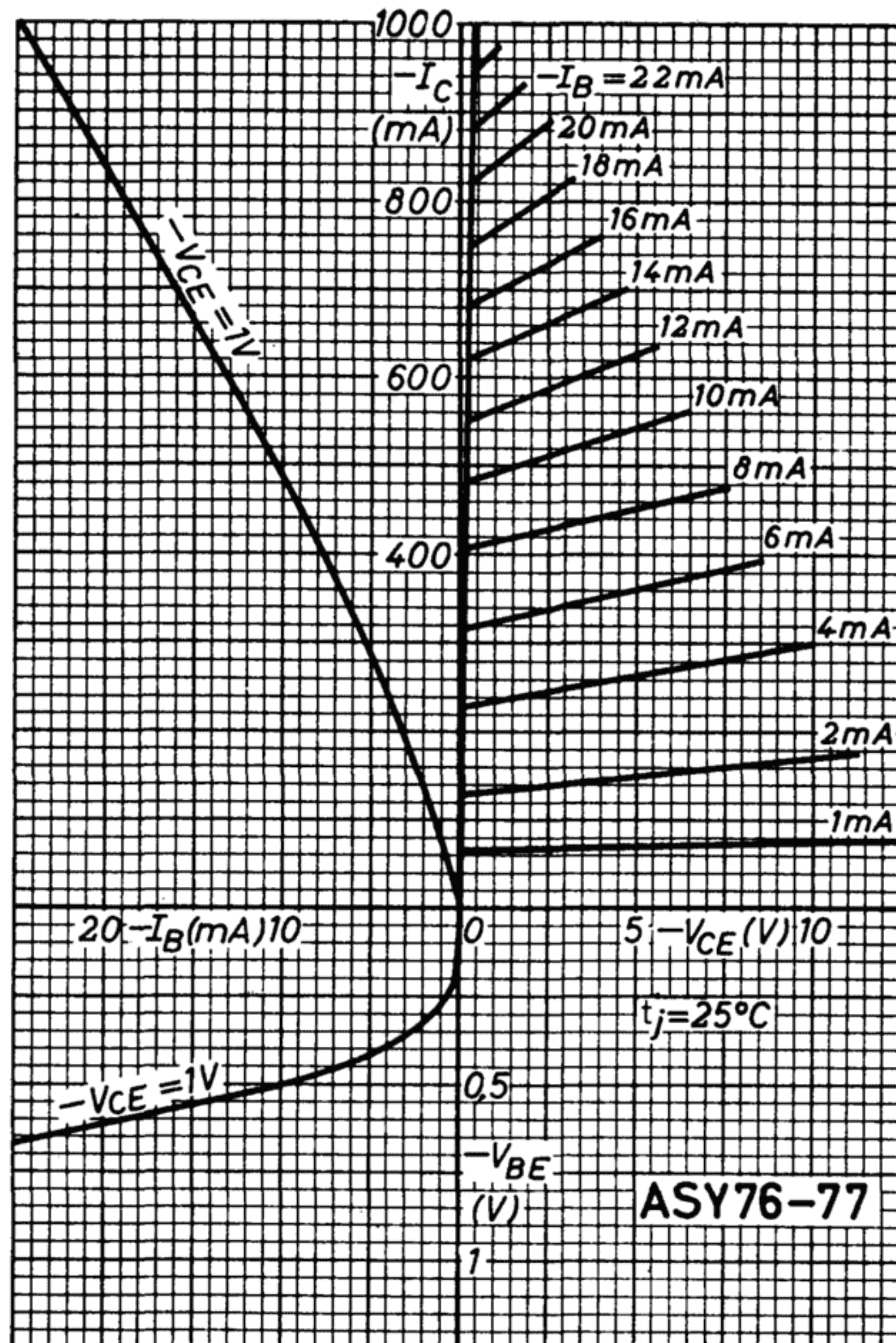
Dimensions en millimètres

Echelle 1/1

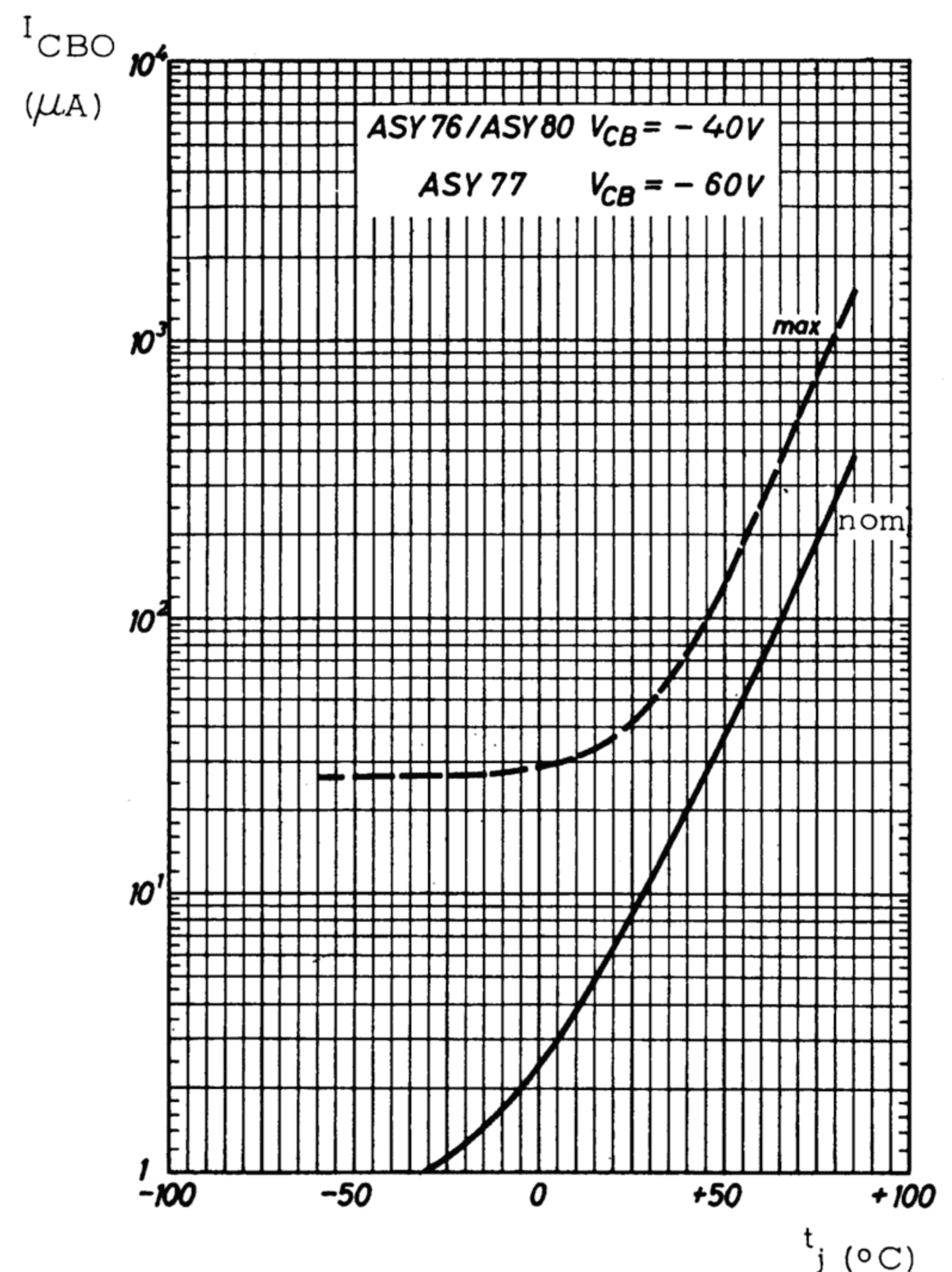
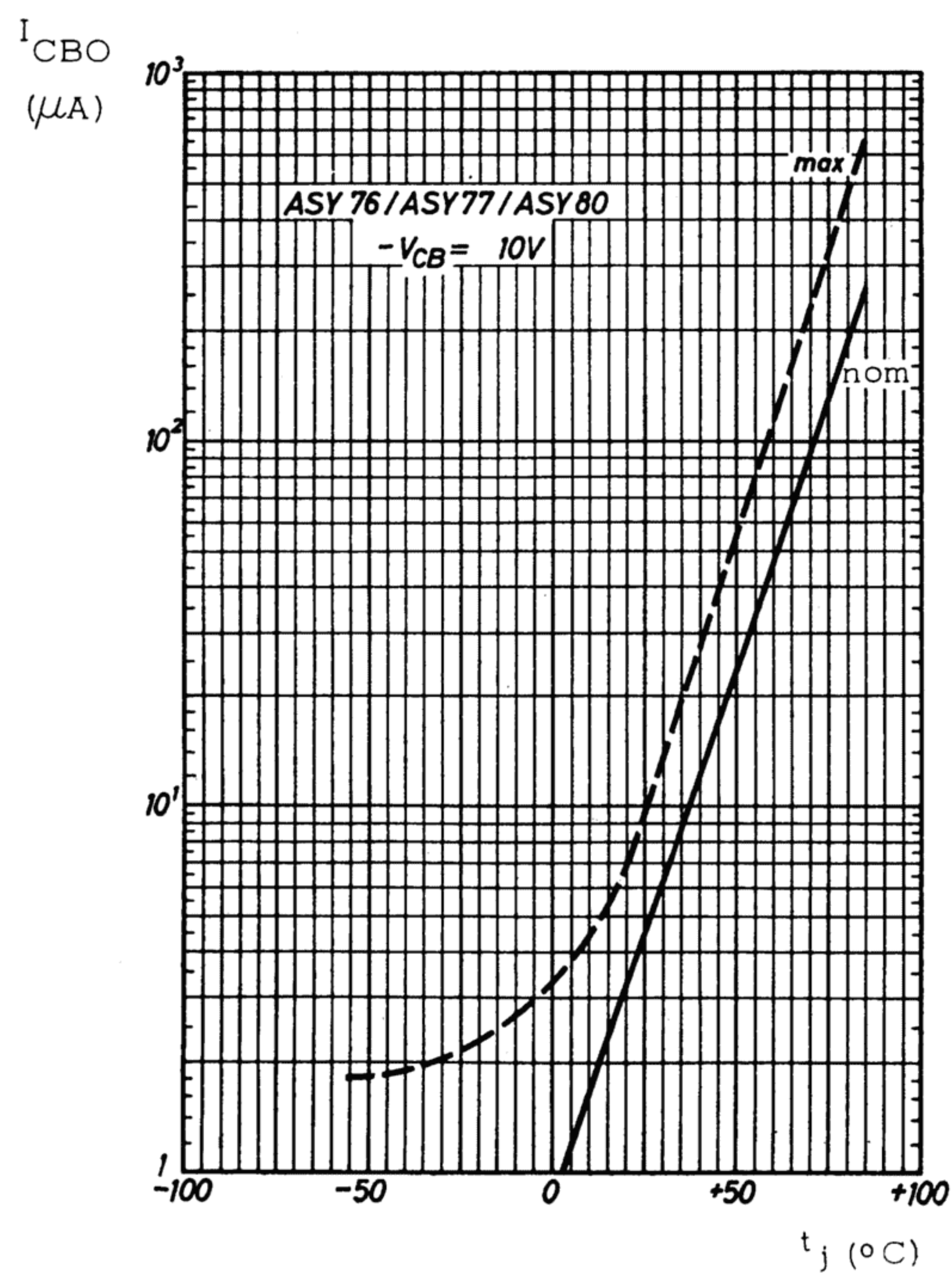
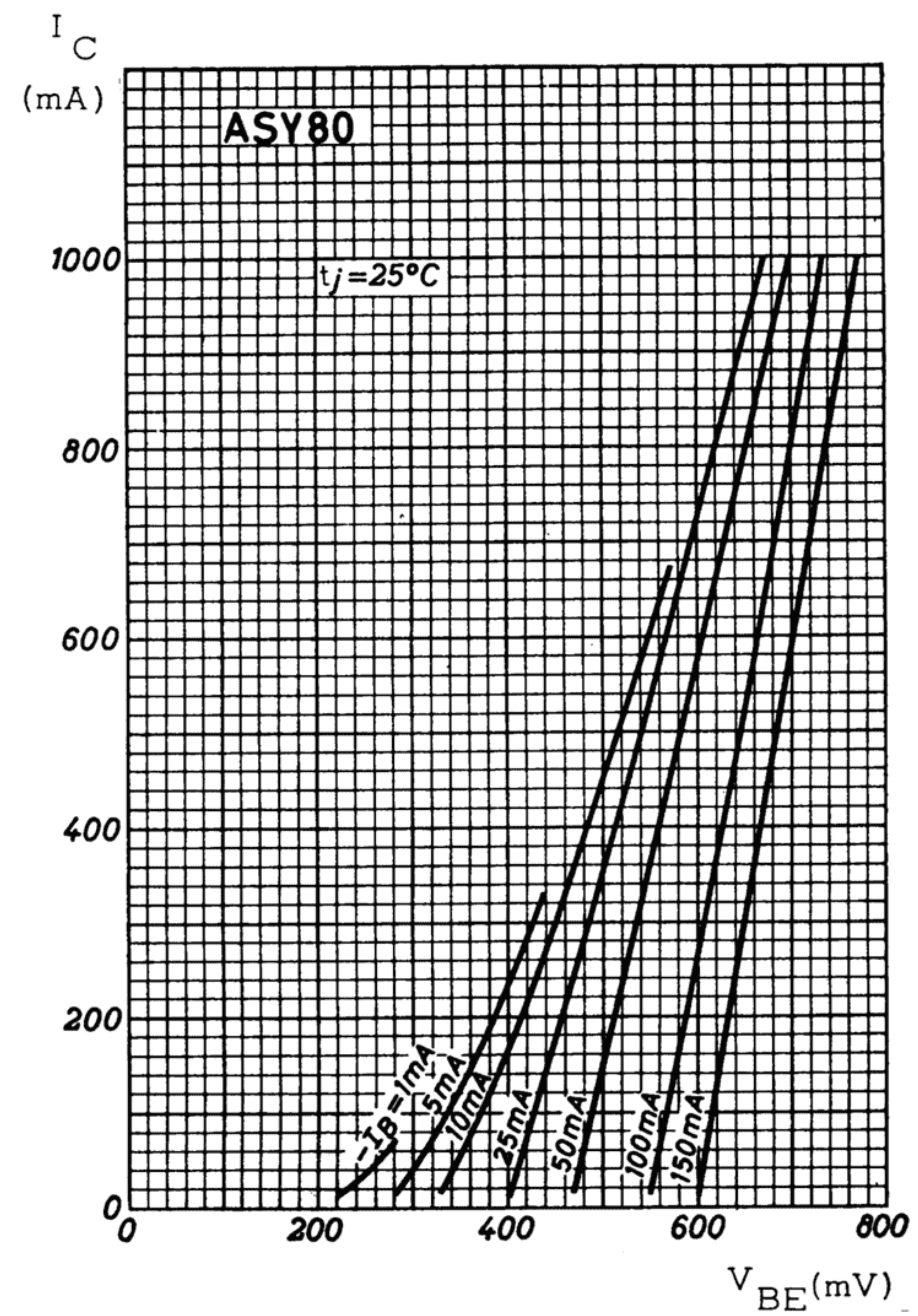
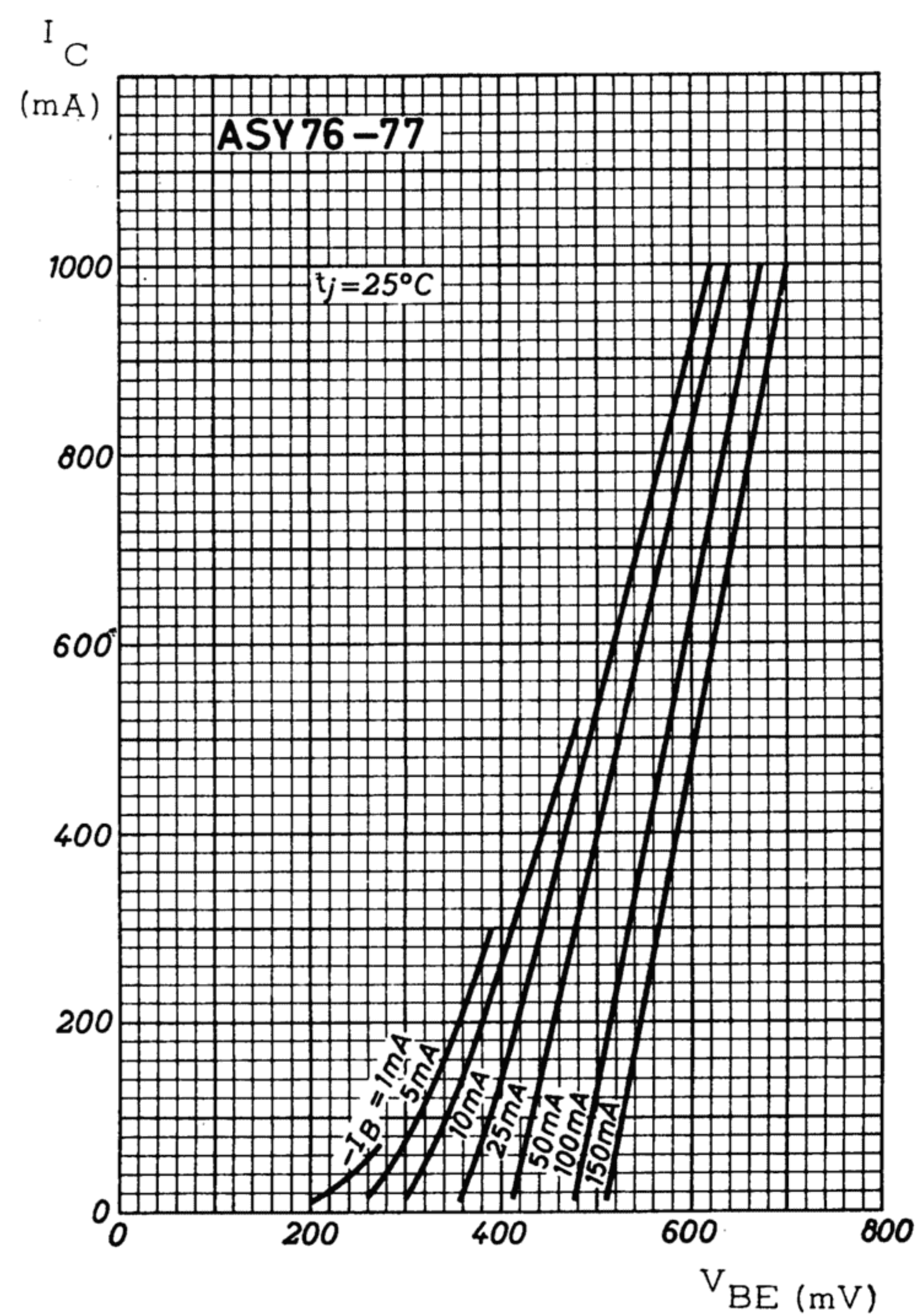
Valeurs limites d'utilisation	Symboles	ASY76	ASY77	ASY80	Unités
Tension collecteur base	V _{CB}	- 40	- 60	- 40	V
Tension collecteur émetteur	V _{CE}	- 32	- 60	- 40	V
Tension émetteur base	V _{EB}	- 10	- 10	- 20	V
Courant crête de collecteur	I _{CM}	← - 1 →			A
Courant continu de collecteur	I _C	← - 500 →			mA
Courant crête d'émetteur	I _{EM}	← 1,2 →			A
Courant continu d'émetteur	I _E	← 540 →			mA
Courant crête de base	I _{BM}	← - 200 →			mA
Courant continu de base	I _B	← - 40 →			mA

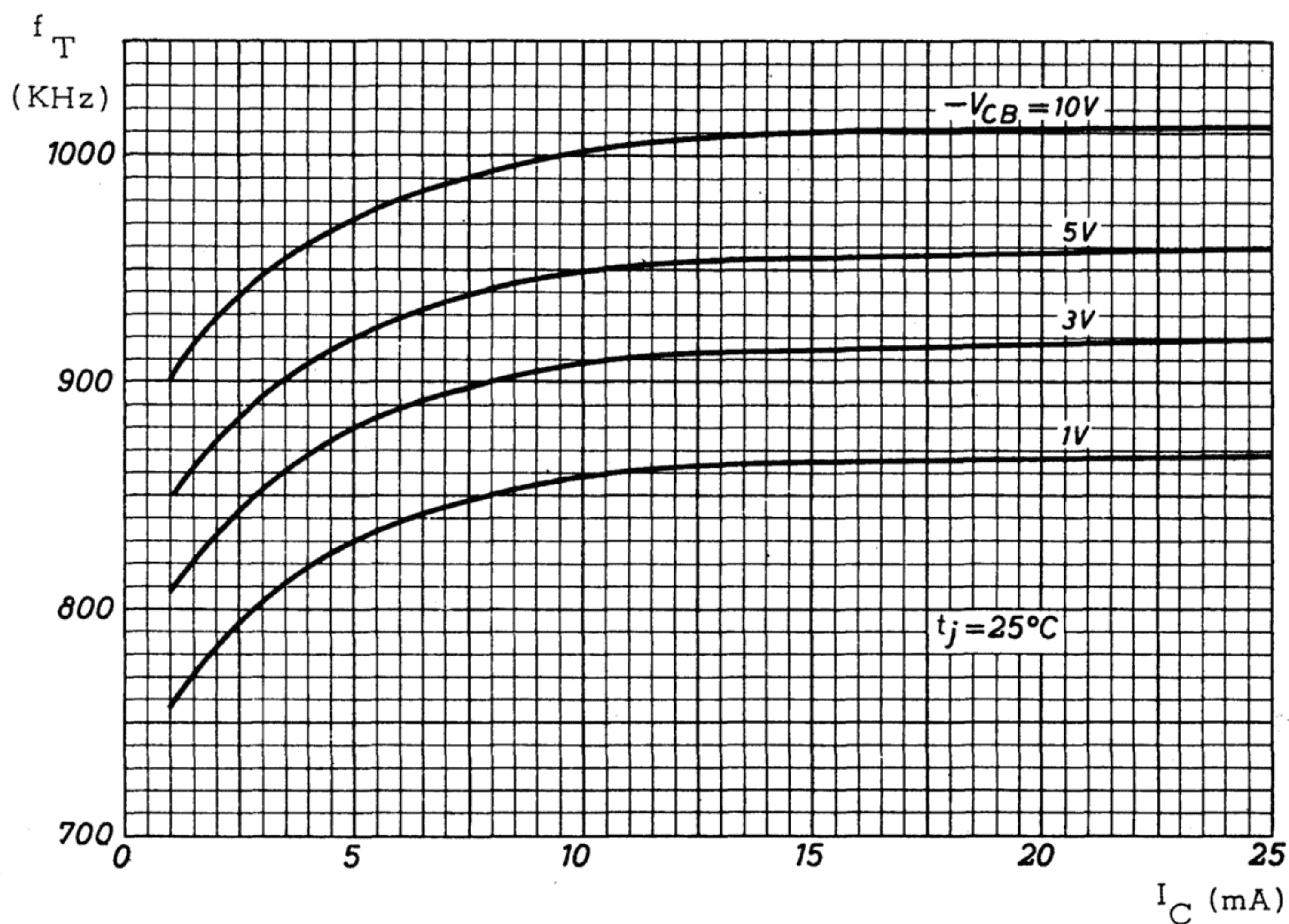
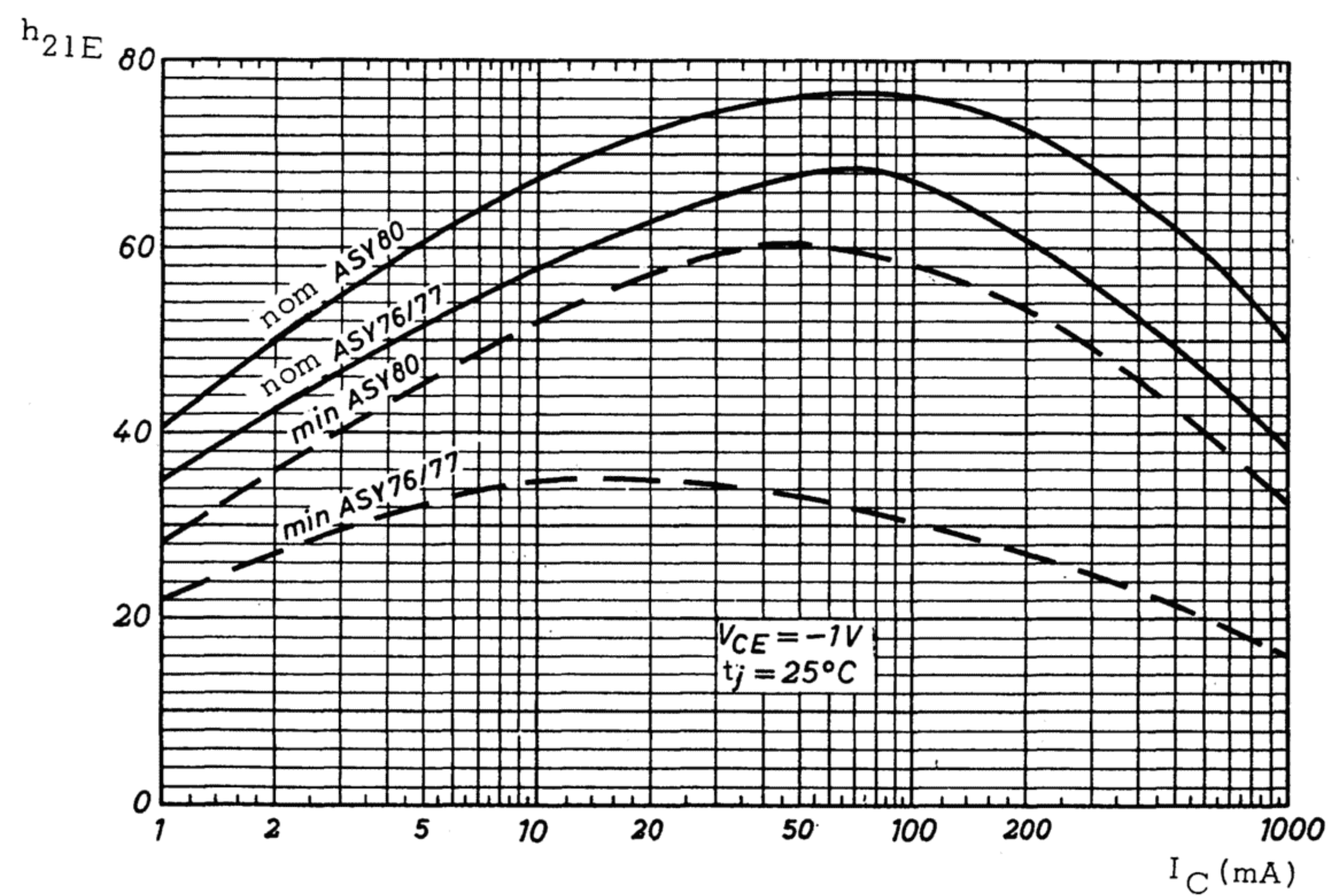
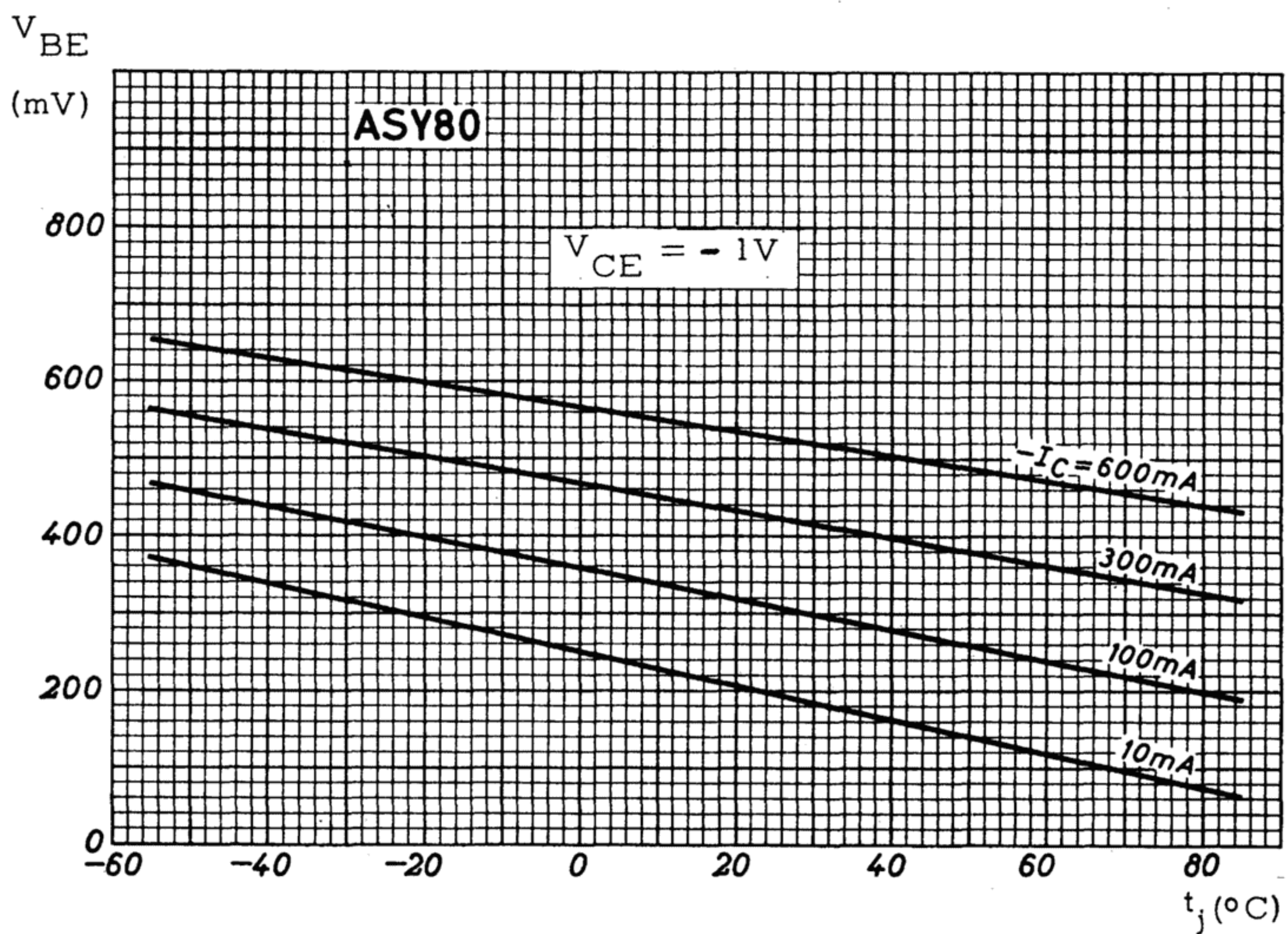
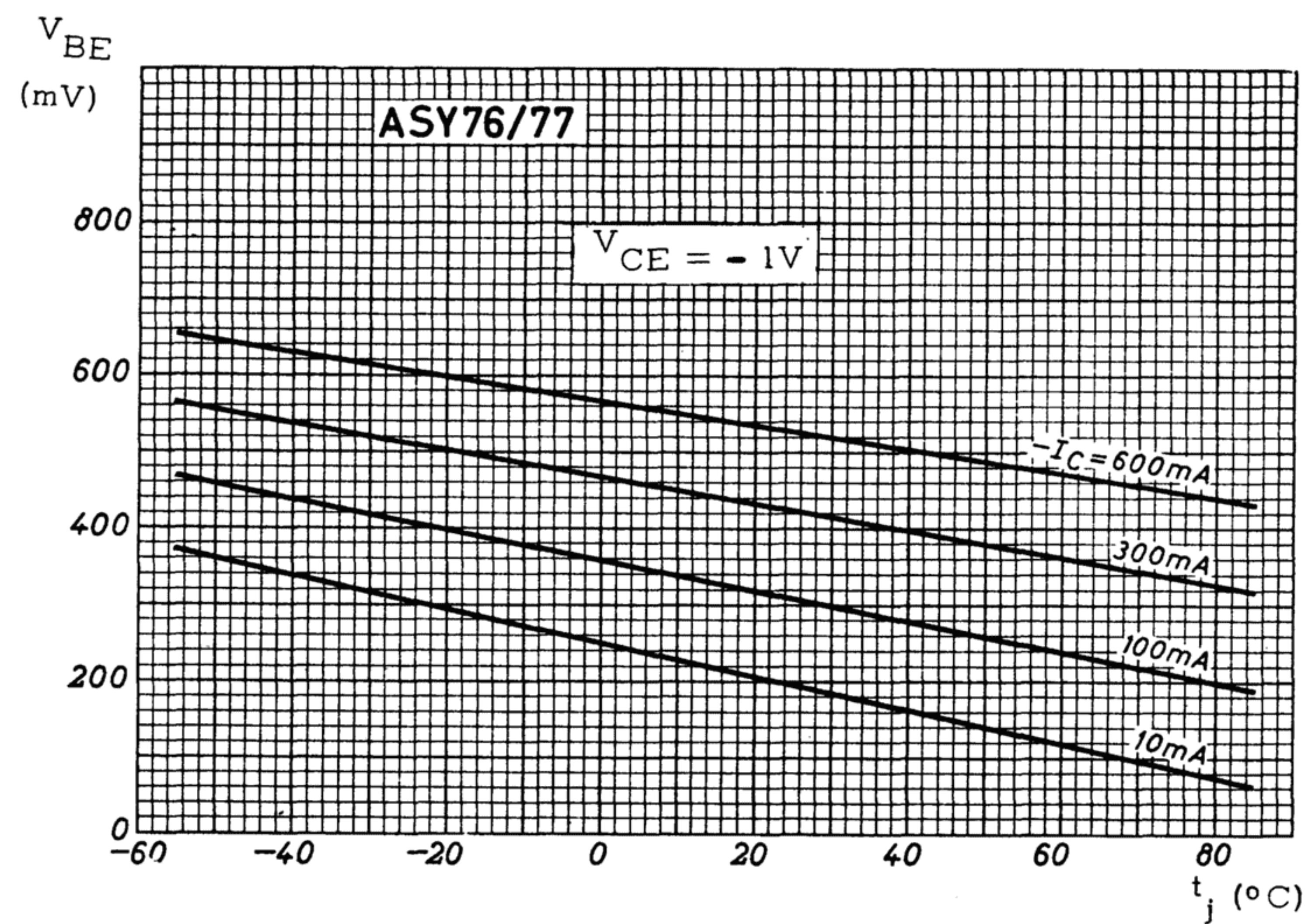
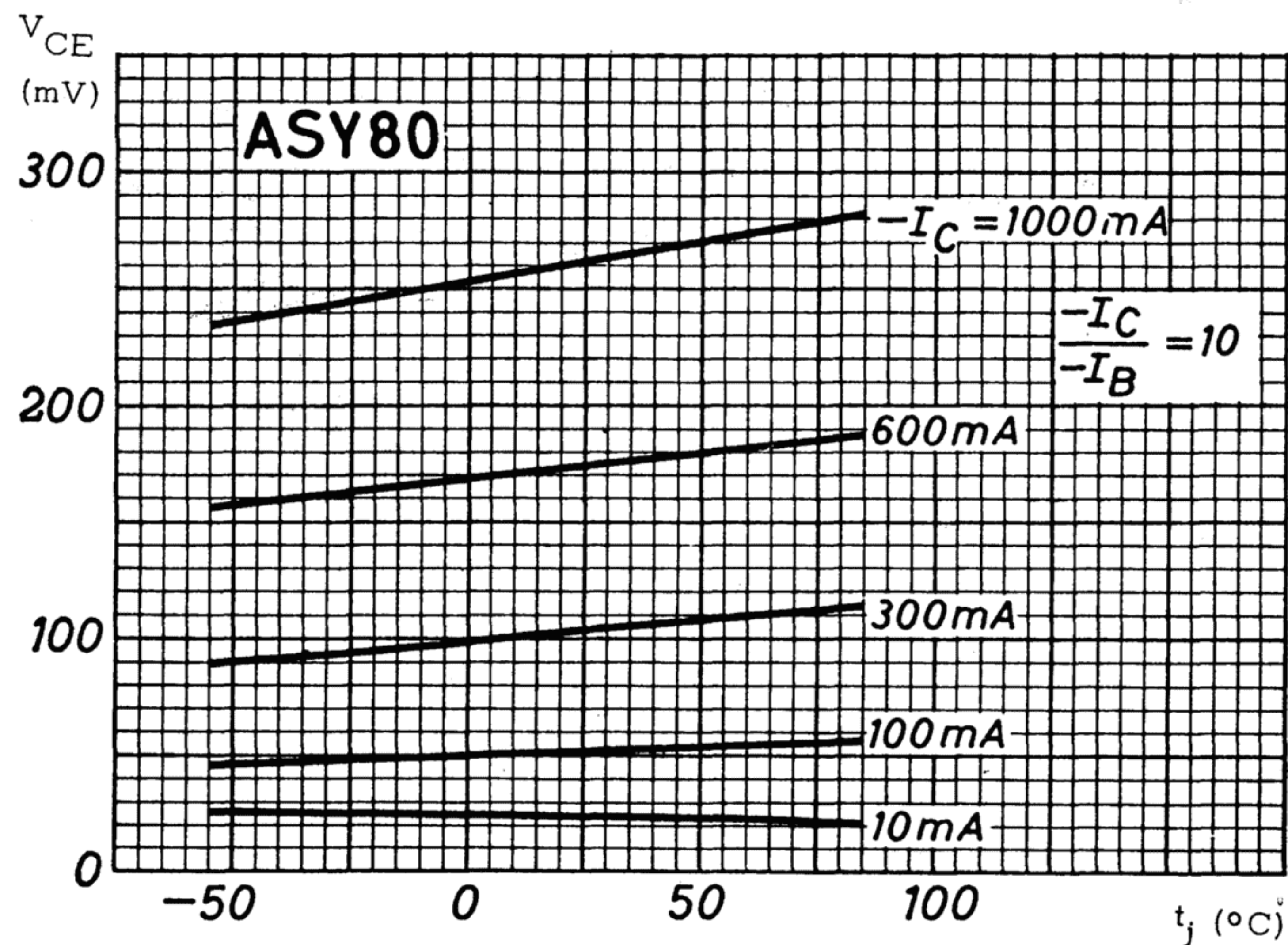
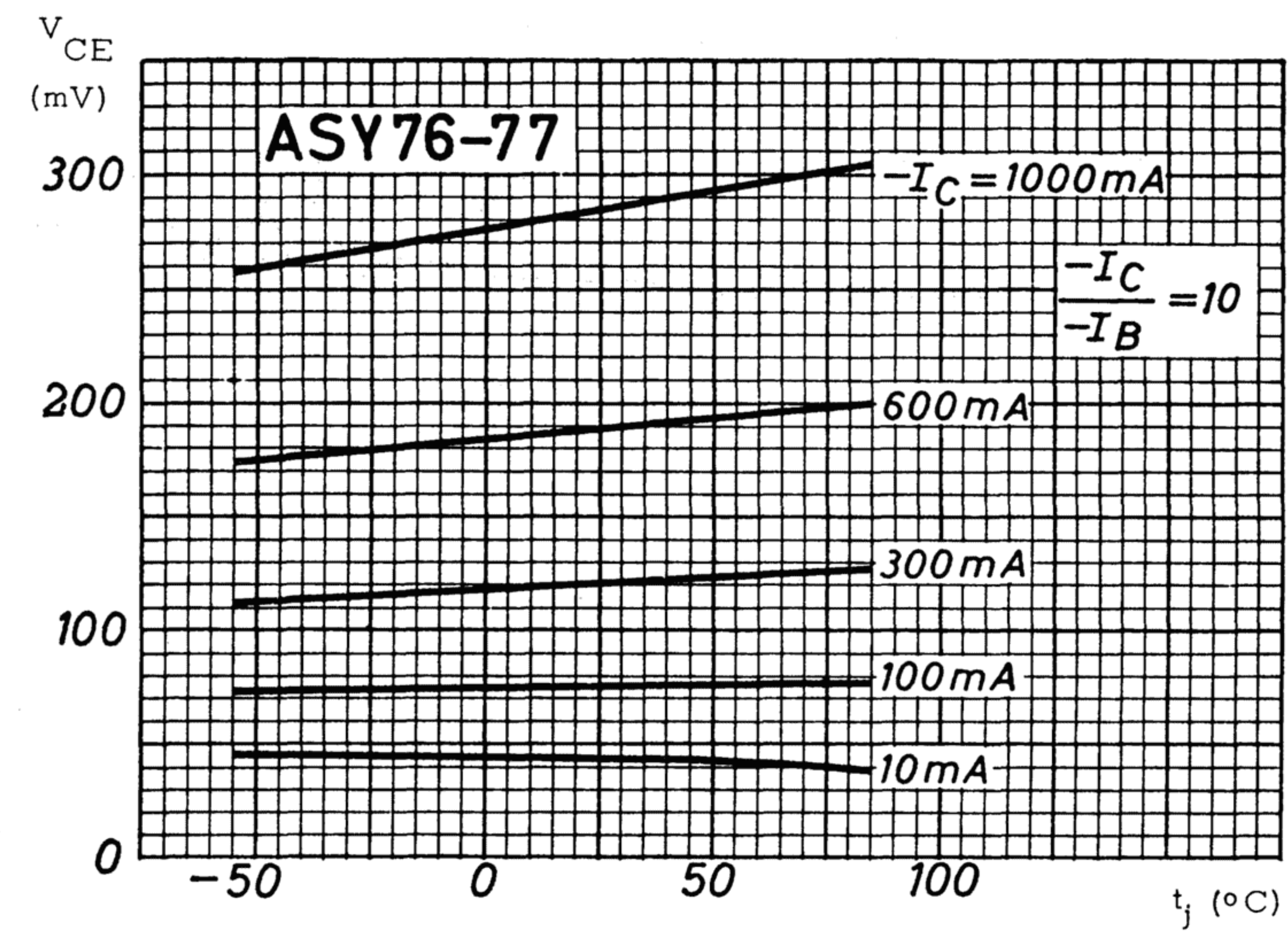
Caractéristiques thermiques					
Puissance de dissipation (t _{amb} = 25° C)	P _{tot}	← 500 →			mW
Température de jonction	t _j	← 85 →			° C
Température de stockage	t _{stg}	← - 65 à + 85 →			° C
Résistance thermique jonction - air ambiant	R _{th}	← 0,25 →			° C/mW
Résistance thermique jonction - air ambiant (transistor monté sur refroidisseur de 12,5 cm2)	R _{th}	← 0,12 →			° C/mW
Résistance thermique jonction - boîtier	R _{th}	← 0,075 →			° C/mW

Caractéristiques statiques ($t_j = 25^\circ\text{C}$)	Conditions de mesure	Symboles	ASY76			ASY77			ASY80			Unités
			min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	min.	nom.	max.	
Tension de claquage collecteur- émetteur	$V_{BE} = 0,6\text{V}, I_C = -600\text{mA}$	V_{CEX}									-32	V
Courant résiduel de collecteur	$I_E = 0, V_{CB} = -10\text{V}$	I_{CBO}		-4,5	-10		-4,5	-10		-4,5	-10	μA
	$I_E = 0, V_{CB} = -40\text{V}$	I_{CBO}			-40						-40	μA
	$I_E = 0, V_{CB} = -60\text{V}$	I_{CBO}						-40				μA
	$V_{CE} = -30\text{V}, V_{BE} = 0,5\text{V}$	I_{CEX}			-30						-30	μA
	$V_{CE} = -60\text{V}, V_{BE} = 0,5\text{V}$	I_{CEX}						-30				μA
	$V_{CE} = -30\text{V}, V_{BE} = 0,5\text{V},$ $t_j = 60^\circ\text{C}$	I_{CEX}			-200						-200	μA
Courant résiduel d'émetteur	$V_{CE} = -60\text{V}, V_{BE} = 0,5\text{V},$ $t_j = 60^\circ\text{C}$	I_{CEX}						-200				μA
	$I_C = 0, V_{BE} = 10\text{V}$	I_{EBO}			-20			-20			-20	μA
Courant de base	$V_{CB} = -6\text{V}, I_E = 10\text{mA}$	I_B			-220			-220				μA
	$V_{CB} = 0, I_E = 50\text{mA}$	I_B							-300		-820	μA
	$V_{CB} = 0, I_E = 300\text{mA}$	I_B	-2,3		-11,5	-2,3		-11,5			-5,9	mA
Tension base émetteur	$V_{CB} = 0, I_E = 300\text{mA}$	V_{BE}		-420	-750		-420	-750		-420	-750	mV
Potentiel flottant émetteur-base	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = 0$ $V_{CB} = -60\text{V}, I_E = 0$	V_{EBfl} V_{EBfl}			300			300			300	mV mV
Tension de saturation collecteur- émetteur	$I_C = -300\text{mA}, I_B = -12\text{mA}$	V_{CEsat}			-300			-300				mV
	$I_C = -300\text{mA}, I_B = -6\text{mA}$	V_{CEsat}									-400	mV
Caractéristiques dynamiques ($t_j = 25^\circ\text{C}$)												
Fréquence de transition	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	f_T	500			500			700			KHz
Facteur de bruit	$V_{CB} = -2\text{V}, I_E = 0,5\text{mA}$ $B = 200\text{Hz}, R_G = 500\Omega$	F			15			15			15	dB
Capacité de collecteur	$f = 1\text{MHz}, V_{CB} = -5\text{V}$	C_c		40	60		40	60		40	60	pF
Capacité d'émetteur	$f = 1\text{MHz}, V_{EB} = -5\text{V}$	C_e		30	50		30	50		30	50	pF
Module de l'impédance de transfert inverse de la tension	$f = 0,5\text{MHz}, V_{CB} = -5\text{V}$ $I_E = 1\text{mA}$	$ Z_{12b} $		75			75			75		Ω



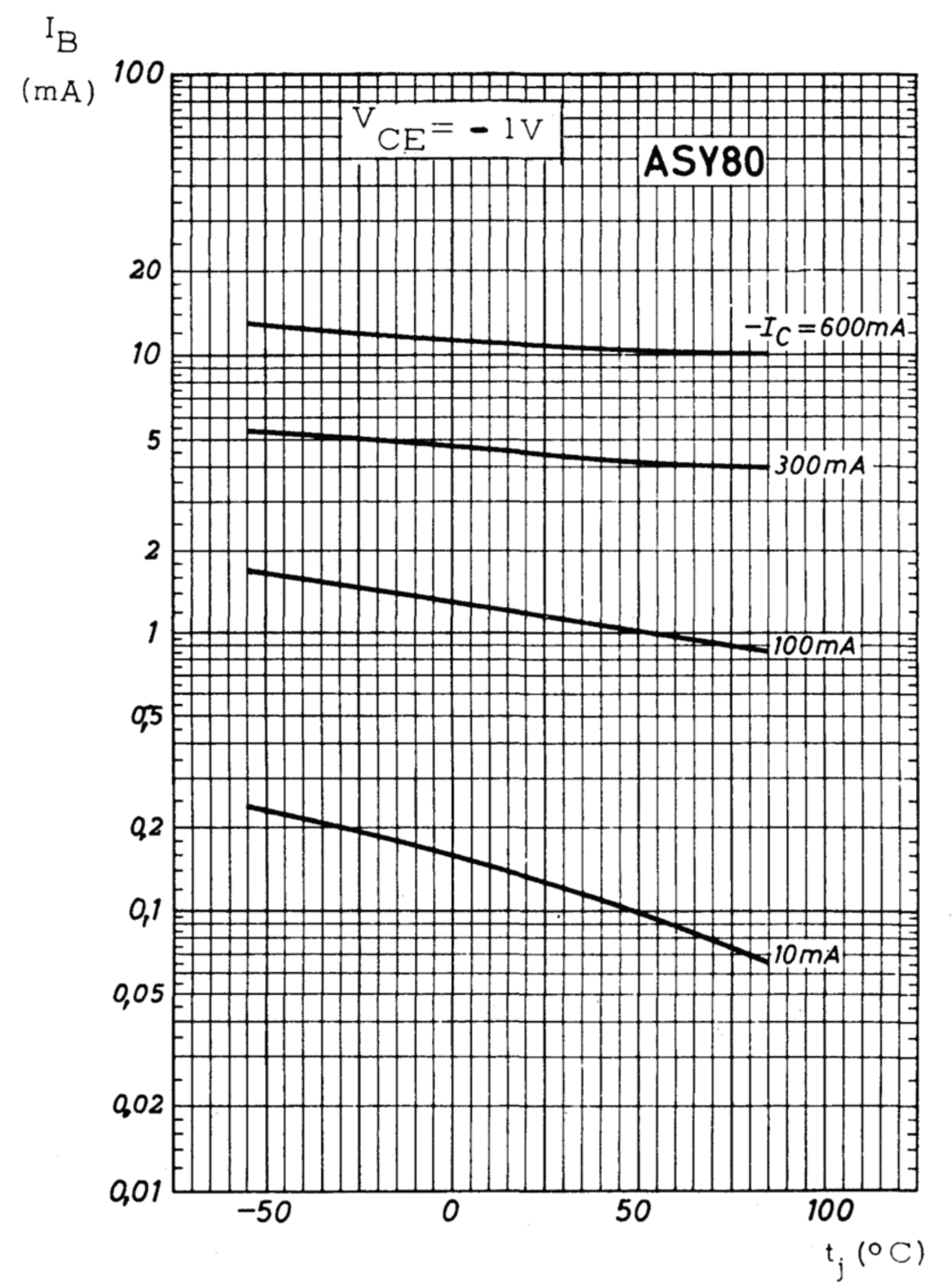
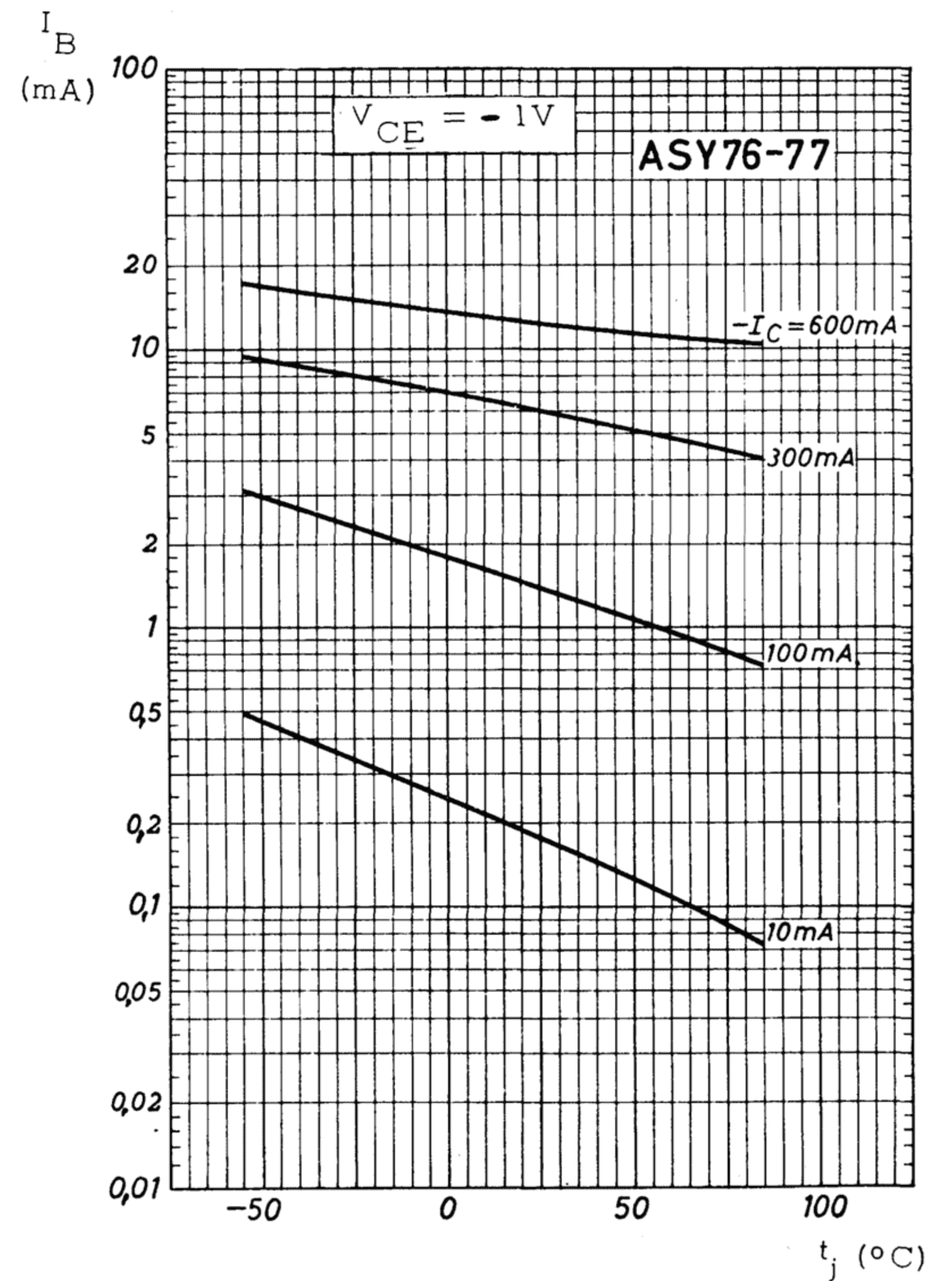
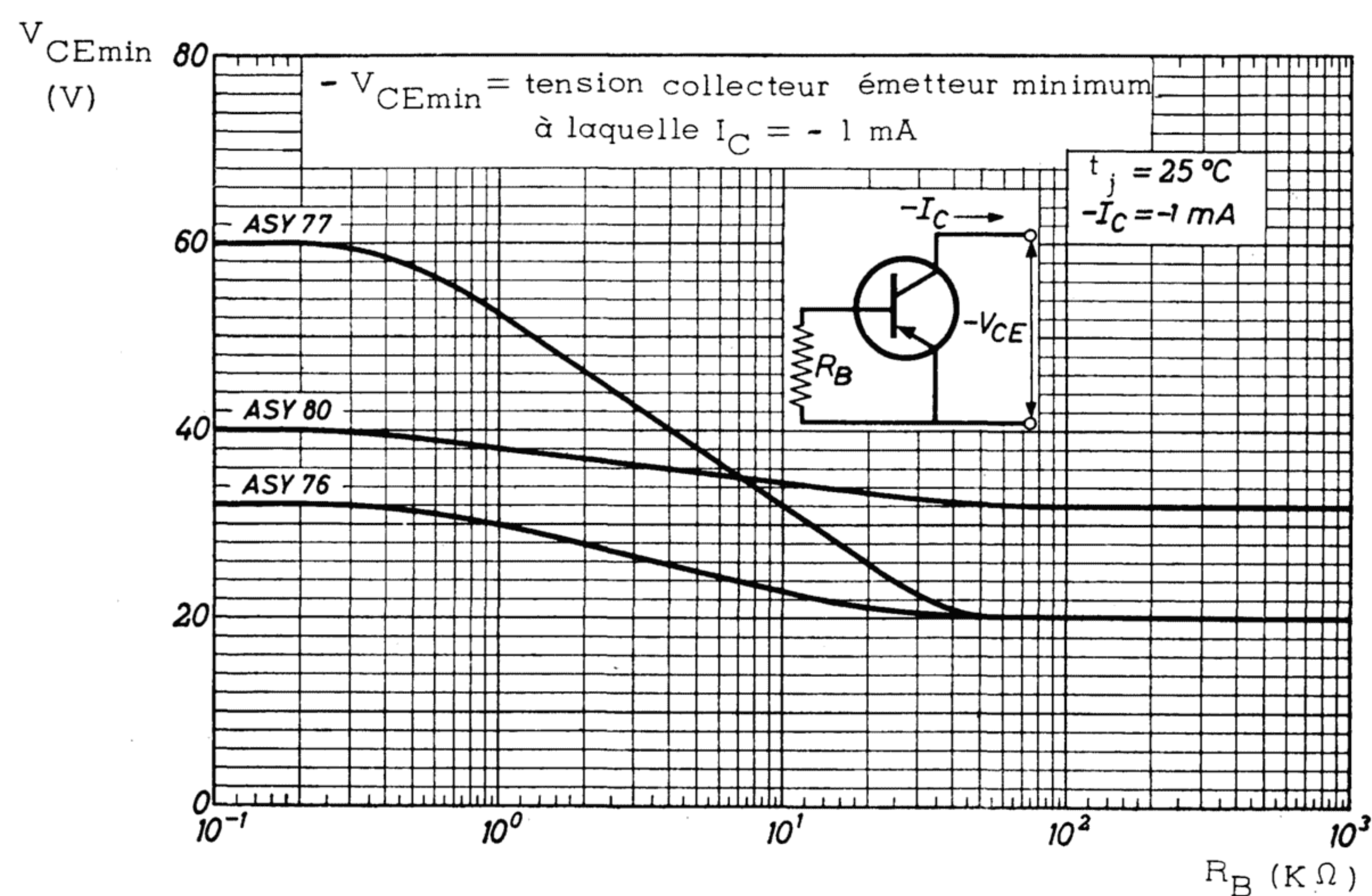
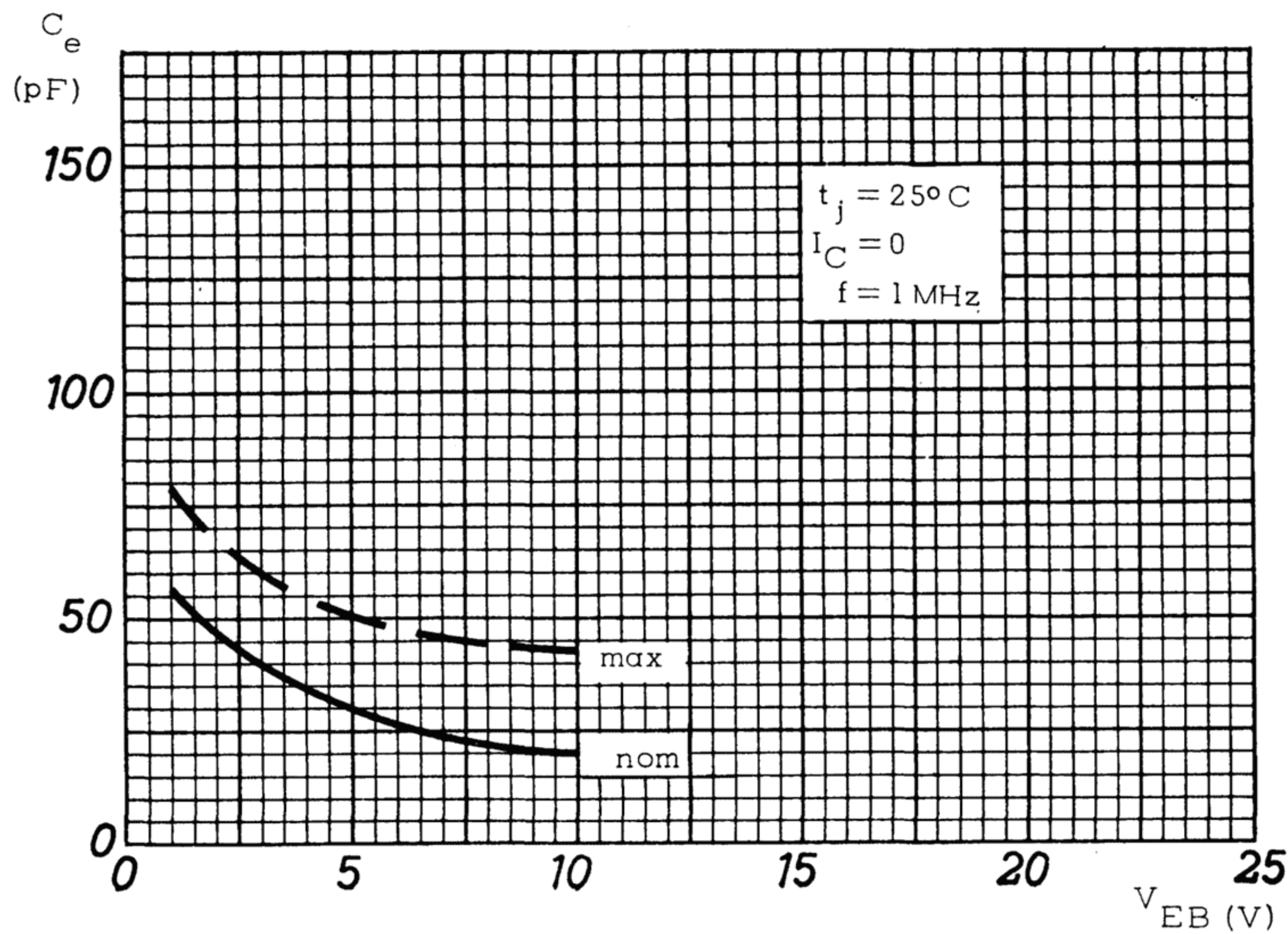
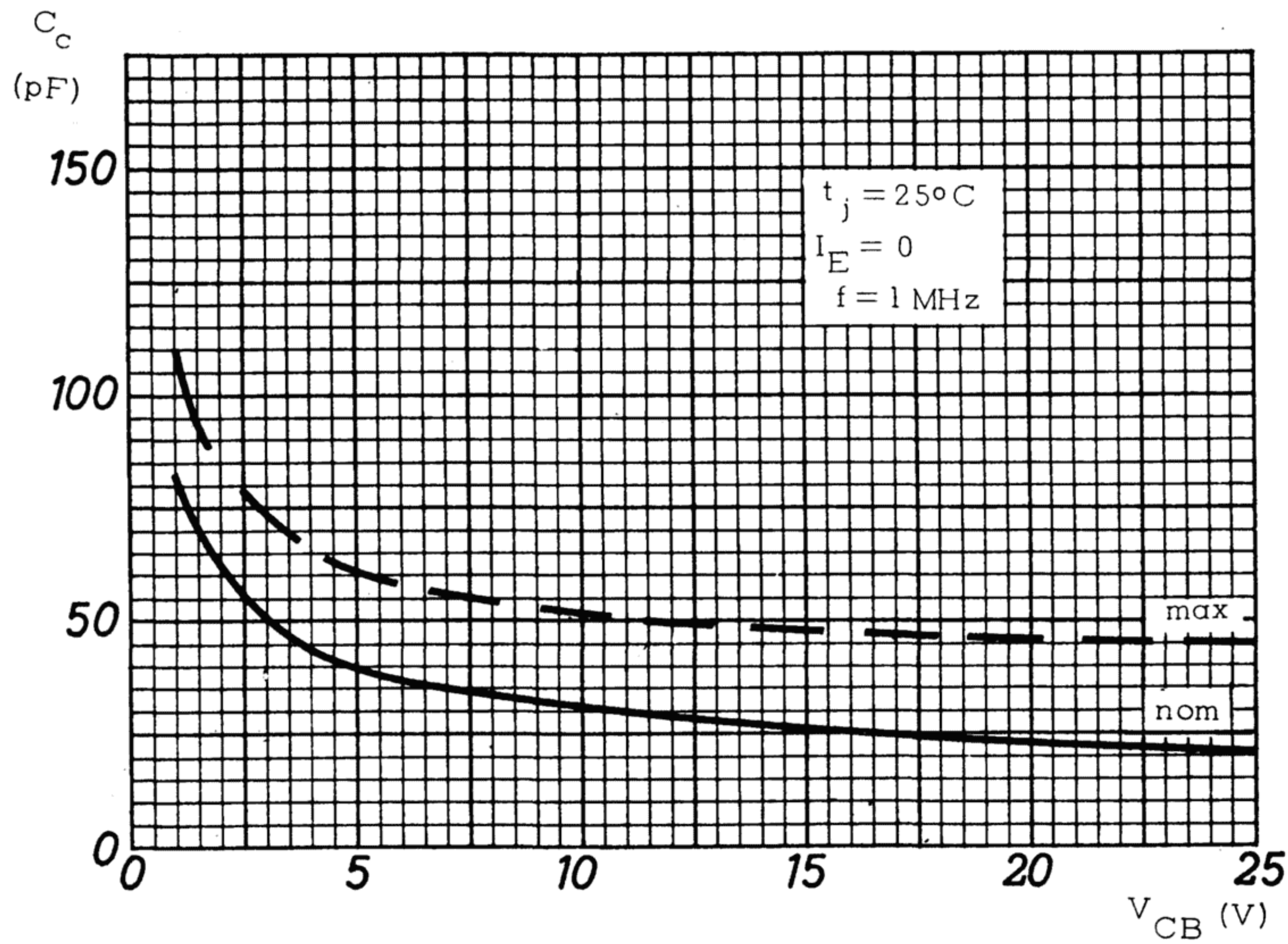
ASY76
ASY77
ASY80

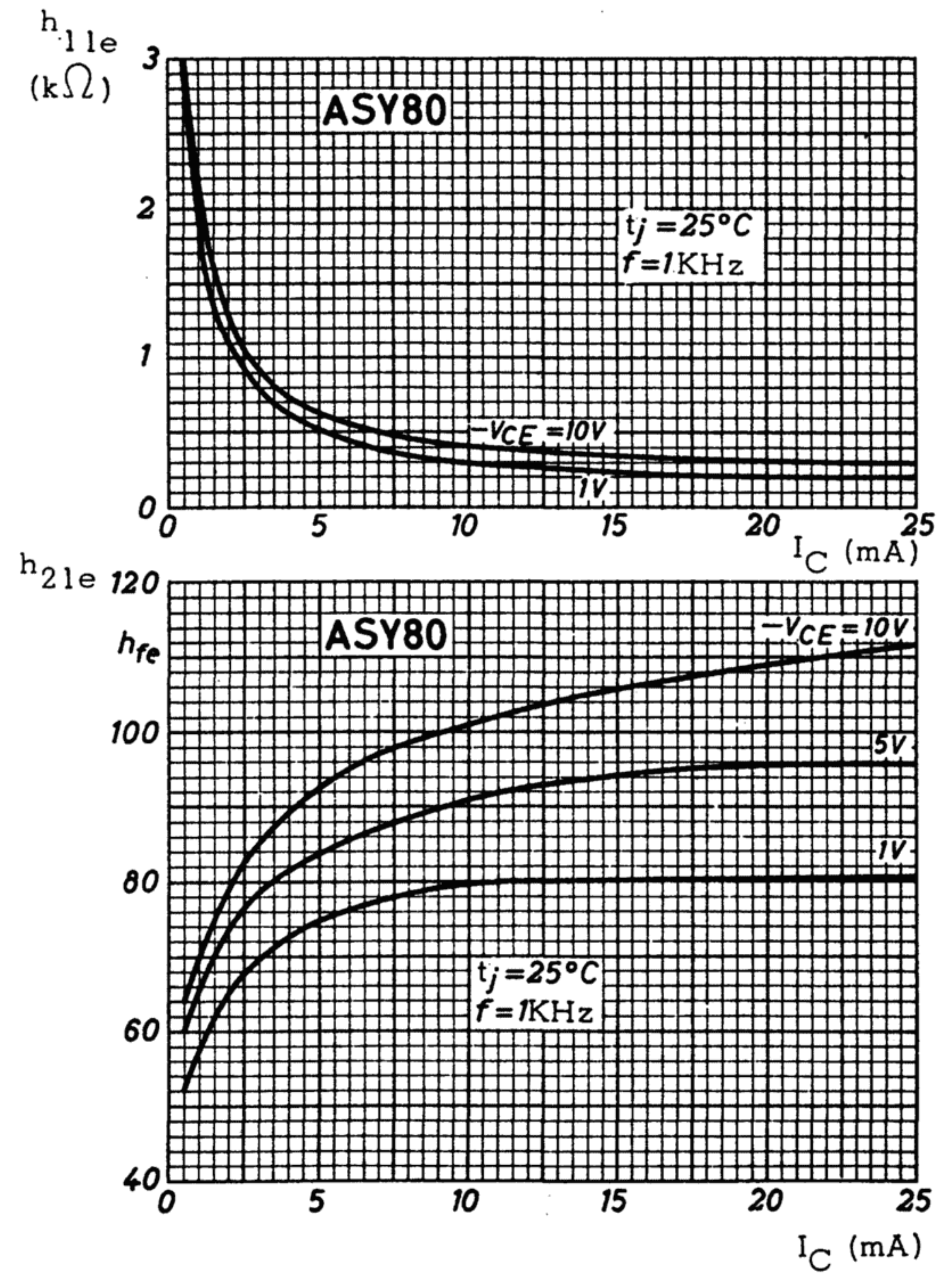
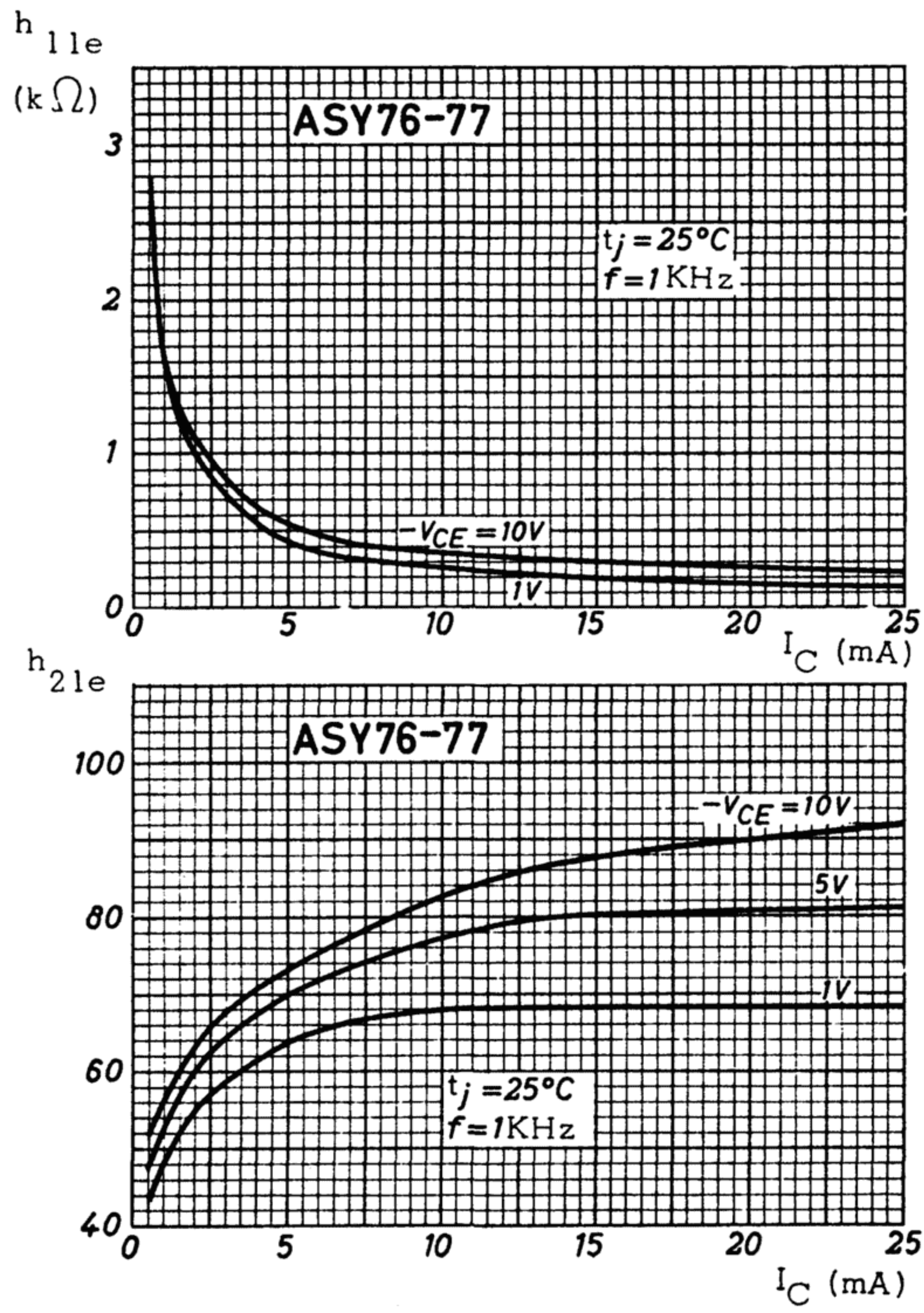




ASY76
ASY77
ASY80

www.datasheetcatalog.com





www.datasheetcatalog.com

